

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DE LILLE 1



Co-tutelle : Convention CIFRE
avec STMicroelectronics



Ecole Doctorale : SPI

Discipline : Micro et Nano Technologies,
Acoustique et T l communications

Nom du candidat : Maciej HARAS

JURY

Pr sident de Jury

Directeurs de Th se

E. DUBOIS Directeur de Recherche CNRS   l'Universit  de Lille1, IEMN
T. SKOTNICKI Directeur de Recherche et D veloppement R&D  
STMicroelectronics   Crolles

Rapporteurs

J.-M. BLUET Professeur   l'INSA   Lyon
J. MARCZEWSKI Professeur   l'Institut de Technologie Electronique de Warszawa,
Pologne

Membres

S. MONFRAY Ing nieur de Recherche et D veloppement R&D  
STMicroelectronics   Crolles
P.-O. CHAPUIS Charg  de Recherche au CNRS, CETHIL   Lyon
J.-F. ROBILLARD Enseignant-Chercheur   l'ISEN, Lille

TITRE DE LA THESE



RESUME

La thermo lectricit  convertit fiablement l' nergie thermique en  nergie  lectrique de mani re directe, silencieusement et sans vibrations. Dans le contexte des r serves limit es en  nergies fossiles, de l'effet de serre et de besoin  nerg tiques mondiaux en hausse, la r cup ration d' nergie thermique dissip e peut  tre une solution d'appoint. Un bon mat riau thermo lectrique int gre des propri t s antagonistes : haute conductivit   lectrique (σ) et faible conductivit  thermique (κ). La thermo lectricit  conventionnelle utilise des mat riaux nocifs, complexes, co teux et incompatible avec des techniques de fabrication massive *ex. CMOS* rendant la thermo lectricit  peu populaire sur le march .

En revanche, les mat riau *CMOS*,   savoir le silicium (*Si*), le germanium (*Ge*) et le silicium-germanium (*Si_xGe_{1-x}*), sont simples, facilement approvisionnement et industriellement compatibles. Ils offrent une excellente conductivit   lectrique (σ) mais leur utilisation dans la thermo lectricit  est limit e par une conductivit  thermique (κ) trop  lev e. Les progr s r cents dans les domaines de micro et nano-fabrication permettent de r duire κ sans affecter σ . Cela permet de fabriquer des g n rateurs thermo lectriques (*TEG*) compatibles *CMOS*, tout en gardant une production massive r duisant le co t.

Les simulations pr sent es placent *Si*, *Ge* et *Si_xGe_{1-x}* dans une position comp titive par rapport aux mat riau thermo lectriques conventionnels,   condition de r duire substantiellement κ . Une r duction de la conductivit  thermique d'un facteur 3 a  t  exp rimentalement d montr e dans des membranes de *Si* int gr es au sein d'une plateforme microm trique con ue, fabriqu e et caract ris e dans le cadre de cette th se.

Soutenance pr vue le 07 janvier 2016   10h30
Amphi IRCICA